

SPICE模型: DDA124EH DDA144EH DDA143EH DDA114YH DDA123JH DDA114EH DDA143TH DDA114TH



DDA (XXXX) H

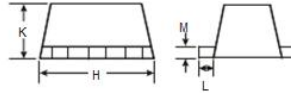
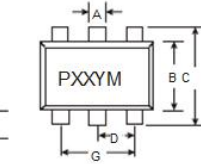
PNP预偏置小信号 SOT-563
双表面贴装晶体管

特点

- 外延平面片建设
- 可提供互补NPN类型 (DDC) 的
- 内置偏置电阻
- 无铅器件

机械数据

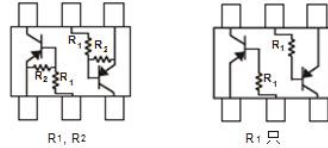
- 案例: SOT-563, 模压塑料
- 外壳材料 - 防火等级94V-0
- 湿度敏感性: 每J-STD-020A等级1
- 码头: 完成 - 雾锡焊
每MIL-STD-202方法208 (注2)
- 终端连接: 见图
- 重量: 0.005克数 (大约)



见注1

SOT-563			
略读	民	最大	典型值
A	0.15	0.30	0.25
B	1.10	1.25	1.20
C	1.55	1.70	1.60
D		0.50	
G	0.90	1.10	1.00
H	1.50	1.70	1.60
K	0.56	0.60	0.60
L	0.15	0.25	0.20
M	0.10	0.18	0.11
尺寸: mm			

P / N	R1	R2	记号
DDA124EH	22KW	22KW	P17
DDA144EH	47KW	47KW	P20
DDA143EH	4.7KW	4.7KW	P08
DDA114YH	10KW	47KW	P14
DDA123JH	2.2KW	47KW	P06
DDA114EH	10KW	10KW	P13
DDA143TH	4.7KW	-	P07
DDA114TH	10KW	-	P12



原理图, 顶视图

最大额定值

@ T_A = 25 °C除非另有说明

特征	符号	价值	单位
电源电压 (6) 上述 (1) 和 (3) ~ (4)	V _{CC}	-50	V
输入电压 (2) 至 (1) 和 (5) ~ (4)	V _{IN}	+10至-40 +10至-40 +10至-30 +6至-40 +5至-12 +10至-40 +5至V _{ITmax} +5至V _{ITmax}	V
输出电流	I _O	-30 -30 -100 -70 -100 -50 -100 -100	mA
输出电流	I _E (最大)	-100	mA
功耗	P _d	150	mW
热阻, 结到环境空气 (注2)	R _{θJA}	833	°X / Ω
操作和储存和温度范围内	T _J , T _{STG}	-55到+150	°X

注意: 1. 包装是非偏置的, 零件可能会在图中所示的方向, 旋转180°或倒置型 (双向) 。
2. 求取在R4电路板在<http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf>推荐的焊盘布局。
3. 没有故意添加铅。

新

电气特性

@ T_A = 25 °C除非另有说明

特性 (DDA143TH & DDA114TH只)	符号	氏	典型值	最大	单位	测试条件
集电极 - 基极击穿电压	BV _{CSO}	-50	—	—	V	I _c = -50mA
集电极 - 发射极击穿电压	BV _{ESD}	-50	—	—	V	I _c = -1mA
发射极 - 基极击穿电压	BV _{ESB}	-5	—	—	V	I _E = -50mA
收藏家Cuto FF电流	I _{CSO}	—	—	-0.5	μA	V _{CE} = -50V
发射Cuto FF电流	I _{ESB}	—	—	-0.5	μA	V _{EB} = -4V
集电极 - 发射极饱和电压	V _{CE (SAT)}	—	—	-0.3	V	I _c /I _B = -2.5mA / -0.25mA I _c /I _B = -1mA / -0.1mA DDA143TH DDA114TH
直流电流传输比	h _{FE}	100	250	600	—	I _c = -1mA, V _{CE} = -5V
增益带宽积*	f _T	—	250	—	兆赫	V _{CE} = -10V, I _C = 5毫安, f = 100MHz的

特征	符号	氏	典型值	最大	单位	测试条件	
输入电压	DDA124EH DDA144EH DDA143EH DDA114YH DDA123JH DDA114EH	V _{L (共基)}	-0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 -0.5	-1.1 -1.1 -1.1 — — -1.1	—	V	V _{CC} = -5V, I _C = -100mA
	DDA124EH DDA144EH DDA143EH DDA114YH DDA123JH DDA114EH	V _{L (上)}	—	-1.9 -1.9 -1.9 — — -1.9	-3.0 -3.0 -3.0 -1.4 -1.1 -3.0	V	V _O = -0.3V, I _C = -5mA V _O = -0.3V, I _C = -2mA V _O = -0.3V, I _C = -20mA V _O = -0.3V, I _C = -1mA V _O = -0.3V, I _C = -5mA V _O = -0.3V, I _C = -10mA
输出电压	DDA124EH DDA144EH DDA143EH DDA114YH DDA123JH DDA114EH	V _{O (上)}	—	-0.1	-0.3	V	I _O /I _I = -10mA / -0.5mA I _O /I _I = -10mA / -0.5mA I _O /I _I = -10mA / -0.5mA I _O /I _I = -5mA / -0.25mA I _O /I _I = -5mA / -0.25mA I _O /I _I = -10mA / -0.5mA
输入电流	DDA124EH DDA144EH DDA143EH DDA114YH DDA123JH DDA114EH	I _I	—	—	-0.36 -0.18 -1.8 -0.88 -3.6 -0.88	mA	V _I = -5V
输出电流		I _{O (共)}	—	—	-0.5	μA	V _{CC} = -50V, V _I = -0V
直流电流增益	DDA124EH DDA144EH DDA143EH DDA114YH DDA123JH DDA114EH	G _I	56 68 20 68 80 30	—	—	—	V _O = -5V, I _C = -5mA V _O = -5V, I _C = -5mA V _O = -5V, I _C = -10mA V _O = -5V, I _C = -10mA V _O = -5V, I _C = -10mA V _O = -5V, I _C = -5mA
增益带宽积*		f _T	—	250	—	兆赫	V _{CE} = -10V, I _C = -5mA, F = 100MHz的

*晶体管 - 仅供参考



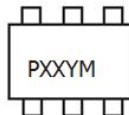
订购信息

(注4)

设备	包装	航运
DDA 124EH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴
DDA 144EH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴
DDA 143EH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴
DDA 114YH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴
DDA 123JH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴
DDA 114EH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴
DDA 143TH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴
DDA 114TH-7	SOT-563	3000 / 磁带&卷轴

注: 4. 包装详细信息, 请访问我们的网站<http://www.diodes.com/datasheets/sp02007.pdf>.

标识信息



PXX = 产品型号标识代码 (见第1页)
YM = 日期代码
Y = 年份例如: T = 2006年
M = 月: 9 = 九月

日期代码的关键

YEAR	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CODE	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	五月	JUN	JUL	八月	SEP	十月	NOV	DEC
CODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

典型曲线 - DDA143EH

